

1SS139/1SS140/1SS141

シリコンエピタキシャルプレーナ形低リークスイッチングダイオード
Silicon Epitaxial Planar Low-Leakage Switching Diodes

● 特長

- 1) 高信頼である。
- 2) ガラス封止である (JEDEC : DO-35)。

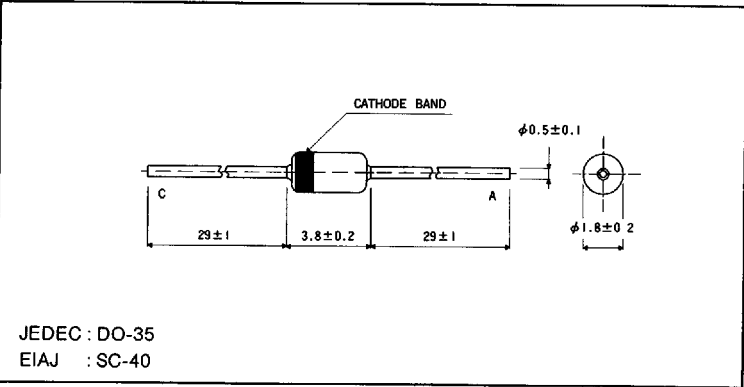
● Features

- 1) High reliability.
- 2) Glass sealed type (JEDEC : DO-35).

● 用途

高速スイッチング用

● 外形寸法図/Dimensions (Unit : mm)



● Applications

High-speed switching.

● カソードバンド色別/Cathode Band Color

Type	1st Color Band	2nd Color Band
1SS139	White	White
1SS140	Violet	Violet
1SS141	Blue	Blue

● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

Parameter		Symbol	Limits	Unit
せん頭逆方向電圧	1SS139	VRM	90	V
	1SS140		55	
	1SS141		40	
直流逆方向電圧	1SS139	VR	80	V
	1SS140		50	
	1SS141		35	
せん頭順方向電流	1SS139	IFM	400	mA
	1SS140		350	
	1SS141		300	
平均整流電流	1SS139	IO	130	mA
	1SS140		120	
	1SS141		110	
サージ電流 (1S)	1SS139	Isurge	600	mA
	1SS140		500	
	1SS141		400	
許容損失		P	300	mW
接合部温度		Tj	175	°C
保存温度範囲		Tstg	-65~+175	°C

● 電気的特性／Electrical Characteristics (Ta=25°C)

Parameter		Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
順方向電圧		V_F	—	1.0	1.2	V	$I_F = 100\text{mA}$
逆方向電流	1SS139	I_R	—	0.45	20	nA	$V_R = 30\text{V}$
	1SS140		—	0.40	10		$V_R = 25\text{V}$
	1SS141		—	0.35	10		$V_R = 20\text{V}$
端子間容量		C_t	—	2.0	5	pF	$V_R = 0.5\text{V}, f = 1\text{MHz}$
逆回復時間		t_{rr}	—	30	50	ns	$V_R = 6\text{V}, I_F = 10\text{mA}, R_L = 50\Omega$

● 電気的特性曲線／Electrical Characteristic Curves (Ta=25°C)

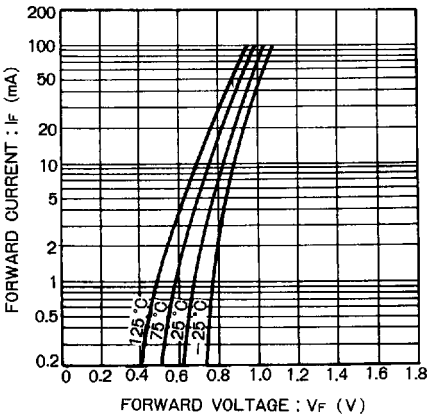


Fig.1 順方向温度特性

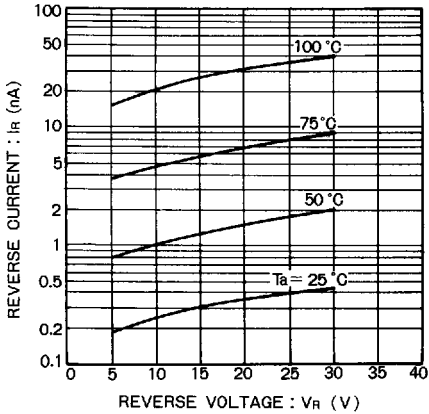


Fig.2 逆方向温度特性

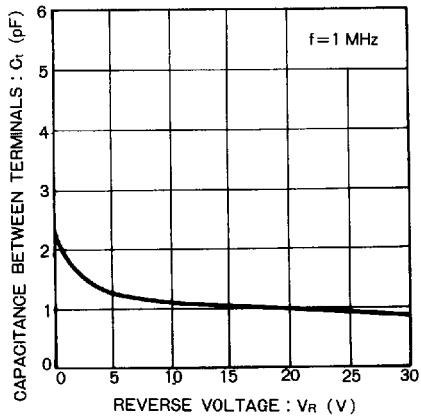


Fig.3 平均整流電流特性

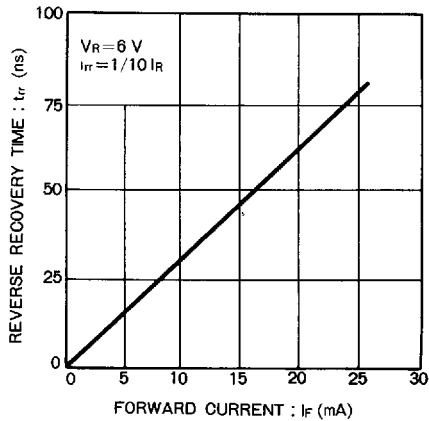


Fig.4 逆回復時間特性

スイッチングダイオード
低リークスイッチングダイオード

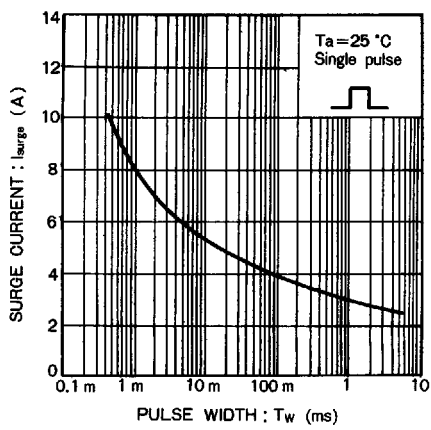


Fig.5 サージ電流特性

